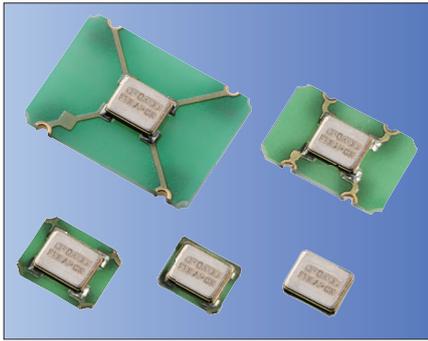




Clock Kシリーズ

CMOS/ 1.8V、2.5V、3.3V/ 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm



RoHS対応品

■特長

- 対応周波数 1.5~160MHz
- CMOS出力
- 電源電圧 1.6~3.63V
- 低消費電流タイプ
- 低位相ノイズ

■用途

- 一般民生機器、ネットワーク、産業機器、Audio Codec、アミューズ

■周波数許容偏差(Overall)

許容偏差 コード × 10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備考
0 ± 50	-10 ~ +70	標準仕様
S ± 30		対応可能周波数に ついてはお問い合わせ ください
U ± 25	-40 ~ +85	
G ± 50		
6 ± 50		

■品名表示方法

KC2520K 25.0000 C □ □ E 00
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名
- ②出力周波数(25.0000 : 25MHz)
- ③出力形態(C : CMOS)
- ④電源電圧

1	1.8V/ 2.5V/ 3.3V 兼用	2	2.5V/ 3.3V兼用
---	------------------------	---	--------------

- ⑤周波数許容偏差(左記表を参照ください)
- ⑥シメトリ/ INH機能

E	45/ 55%
---	---------

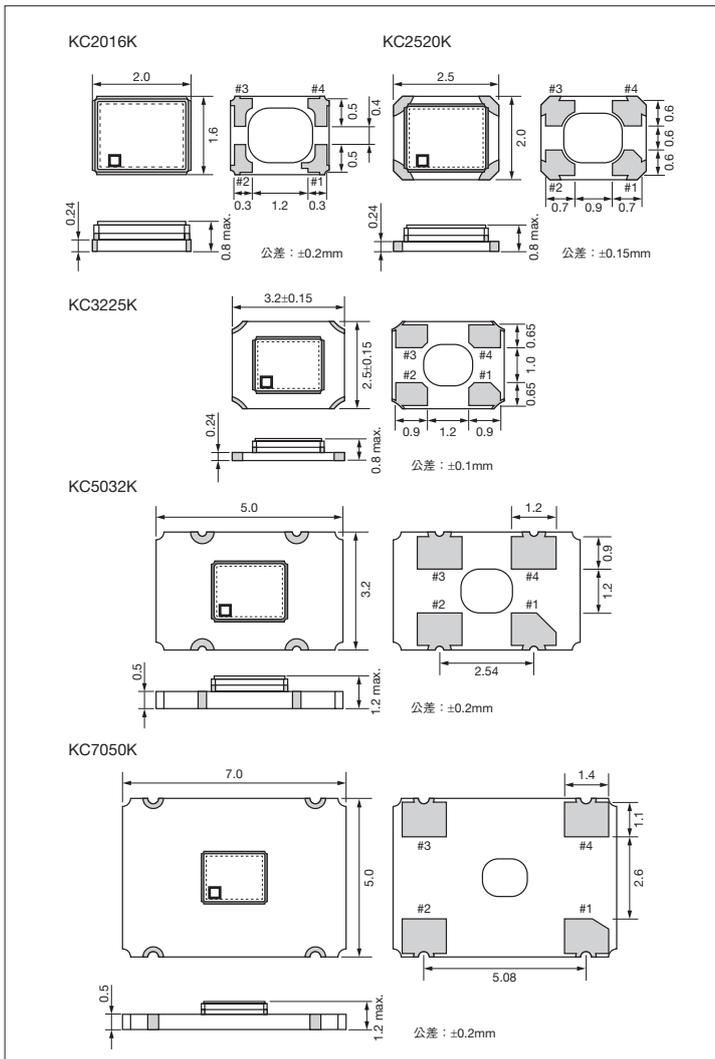
- ⑦個別仕様(カタログ仕様は「00」になります)

包装形態 テーピング

KC7050K/ KC5032K	1000個/ リール
KC3225K/ KC2520K/ KC2016K	2000個/ リール

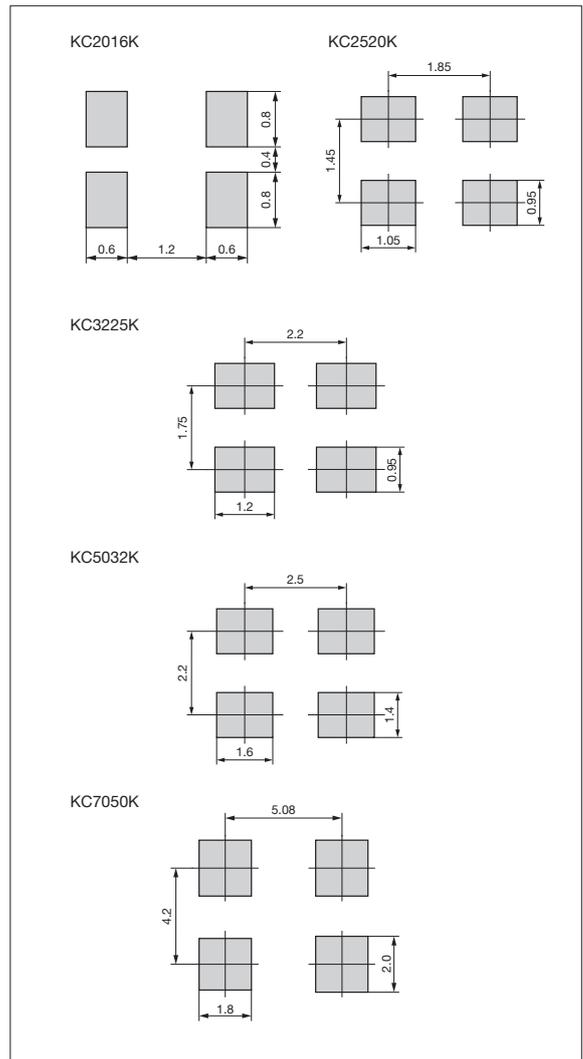
■形状・寸法

(単位 : mm)



■推奨ランドパターン

(単位 : mm)





Clock Kシリーズ

CMOS/ 1.8V、2.5V、3.3V/ 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm

■ 規格

項目	記号	条件		Min.	Max.	単位
出力周波数範囲*	f _o			1.5	160	MHz
周波数許容偏差	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内での温度特性、電源電圧変動、負荷容量変動、経年変化(1 year @25°C)、振動・衝撃を含む	Temp. : -10~+70°C / -40~+85°C / -40~+105°C	-50	+50	×10 ⁻⁶
			Temp. : -10~+70°C	-30	+30	
			Temp. : -10~+70°C	-25	+25	
保存温度範囲	T _{stg}			-55	+125	°C
動作温度範囲	T _{use}			-10	+70	°C
				-40	+85	
				-40	+105	
最大定格電圧	—			-0.3	+4.0	V
電源電圧	V _{cc}	Code④ : 1 : 1.5≤F ₀ ≤125MHz		+1.60	+3.63	V
		Code④ : 2 : 125<F ₀ ≤160MHz		+2.25	+3.63	
消費電流 (最大負荷時)	I _{cc}	1.5≤F ₀ ≤24MHz	1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	2.5	mA
			2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	3.0	
			2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	3.5	
		24<F ₀ ≤40MHz	1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	3.5	
			2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	4.5	
			2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	5.0	
		40<F ₀ ≤62.5MHz	1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	5.0	
			2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	5.5	
			2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	6.0	
		62.5<F ₀ ≤80MHz	1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	6.0	
			2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	6.5	
			2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	8.0	
80<F ₀ ≤125MHz	1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	11.0			
	2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	14.0			
	2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	17.0			
125<F ₀ ≤160MHz	2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	25.0			
	2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	27.0			
スタンバイ時電流	I _{std}	1.5≤F ₀ ≤80MHz		—	5.0	μA
		80<F ₀ ≤160MHz		—	10.0	
波形シンメトリ	SYM	@50% V _{cc}		45	55	%
立上り/ 立下り時間 (10%~90% Output Level)	Tr/ Tf	1.5≤F ₀ ≤80MHz	1.6≤V _{cc} ≤2.25V	—	6.0	ns
			2.25<V _{cc} ≤2.8V	—	5.0	
			2.8<V _{cc} ≤3.63V	—	4.5	
		80<F ₀ ≤125MHz	1.6<V _{cc} ≤3.63V	—	4.0	
125<F ₀ ≤160MHz	2.25<V _{cc} ≤3.63V	—	2.5			
LLレベル出力電圧	V _{OL}	I _{OL} = 4mA (F ₀ ≤80MHz), I _{OL} = 8mA (F ₀ >80MHz)		—	10% V _{cc}	V
HLレベル出力電圧	V _{OH}	I _{OH} = -4mA (F ₀ ≤80MHz), I _{OH} = -8mA (F ₀ >80MHz)		90% V _{cc}	—	V
出力負荷条件 (CMOS)	L _{CMOS}			15		pF
LLレベル入力電圧	V _{IL}			—	30% V _{cc}	V
HLレベル入力電圧	V _{IH}			70% V _{cc}	—	V
ディセーブル時間	t _{dis}	1.5≤F ₀ ≤80MHz		—	200	ns
		80<F ₀ ≤125MHz		—	100	
		125<F ₀ ≤160MHz		—	100	
イネーブル時間	t _{ena}			—	5	ms
発振開始時間	t _{str}	1.5≤F ₀ ≤80MHz		—	5	ms
		80<F ₀ ≤125MHz		最小動作電圧を0 sec.とする		
		125<F ₀ ≤160MHz		—	10	
1Sigma Jitter	J _{sigma}	1.5≤F ₀ ≤80MHz		—	5	ps
		80<F ₀ ≤125MHz		Wavecrest SIA-3000にて測定		
		125<F ₀ ≤160MHz		—	3	
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}	1.5≤F ₀ ≤80MHz		—	50	ps
		80<F ₀ ≤125MHz		Wavecrest SIA-3000にて測定		
		125<F ₀ ≤160MHz		—	25	
Phase Jitter	J _{Phase}	@25MHz		—	1.0	ps





Clock Kシリーズ

CMOS/ 1.8V、2.5V、3.3V/ 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5、5.0×3.2、7.0×5.0mm

項目	記号	条件		Min.	Max.	単位
Phase Noise	-	@25MHz	@10Hz offset	Typ. -89		dBc/ Hz
			@100Hz offset	Typ. -119		
			@1kHz offset	Typ. -143		
			@10kHz offset	Typ. -157		
			@100kHz offset	Typ. -160		
			@1MHz offset	Typ. -162		
			@10MHz offset	Typ. -162		

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。
* レンジ外の周波数においては、お問い合わせください。

パッド配置	
#1	INH
#2	Case GND
#3	Output
#4	Vcc

INH機能	
Pad1	Pad3 (Output)
Open	Active
"H" Level	Active
"L" Level	High Z (発振停止)

